

182-尺寸单晶-10BB-双面半片



光致衰减

辐照度:1000W/m², 标准太阳光谱 (AM1.5), 总辐照量:5kwh/m², 光致衰减为“0”



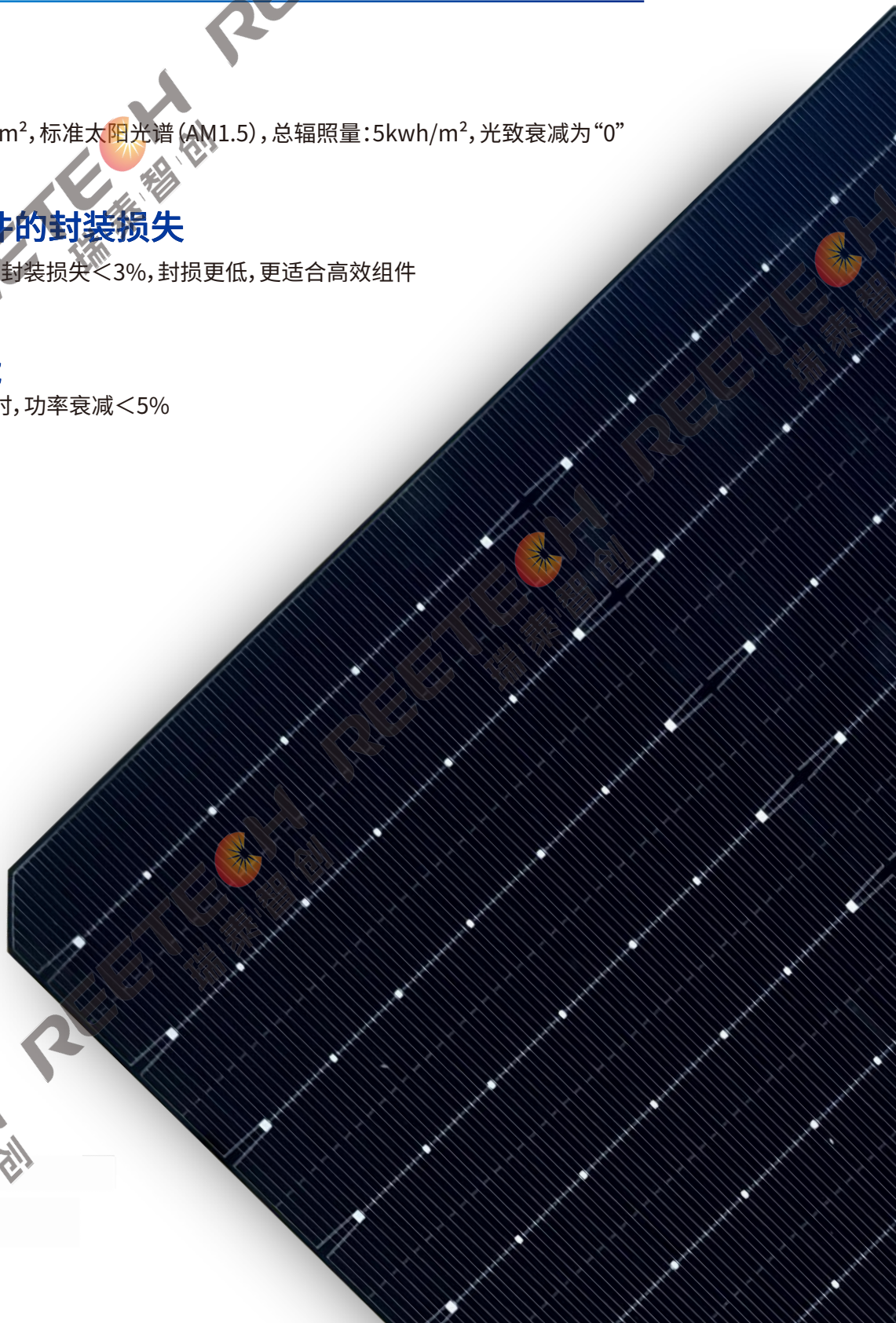
电池到组件的封装损失

电池片到组件的封装损失<3%, 封损更低, 更适合高效组件



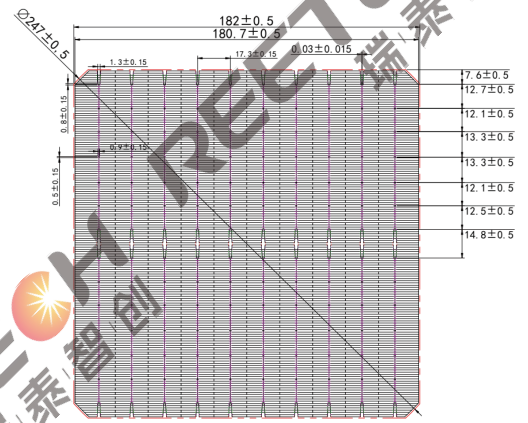
抗PID性能

-1500V, 192小时, 功率衰减<5%

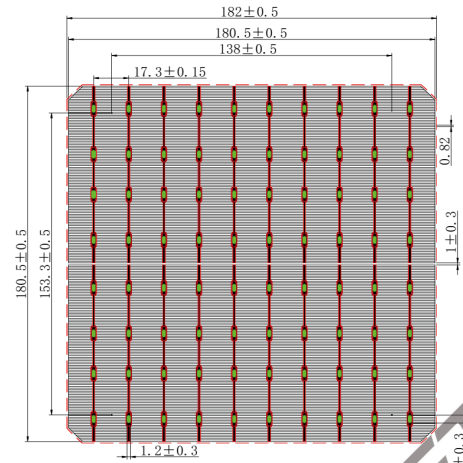


产品列表 / Product list

硅片类型 Silicon type	单晶 Mono-crystalline
尺寸规格 size	182*182±0.5Φ247mm
正面 Front surface	十主栅/ten busbar 间距interval:17.3mm±0.15mm 正面焊盘宽度 Front busbar width:1.3/0.8±0.15mm 0.9/0.5±0.15mm
背面 Rear surface	十主栅/ten busbar 间距interval:17.3mm±0.15mm 背面电极宽度/ Back electrode:1.2 ±0.3mm
电池片厚度 Thickness	175±17.5μm
图形代码 Graphic code	YB02



正面图形



背面图形

标准检验条件 (STC) / Standard Test Condition (STC)

a.光强Intensity	1000W/m ²
b.光谱Spectrum	AM1.5G
c.温度Temperature	25°C

温度系数 / Temperature coefficient

a.Voc	-0.3%/°C
b.Isc	+0.06%/°C
c.Pm	-0.39%/°C

正面效率 / Front Efficiency

档位 Eff(%)	效率区间 Efficiency	功率 Pmpp(W)	最大功率电流 Impp(A)	最大功率电压 Umpp(v)	短路电流 Isc(A)	开路电压 Uoc(V)
23.3	23.3以上	7.69	12.842	0.599	13.506	0.695
23.2	23.2-23.3	7.66	12.808	0.598	13.466	0.694
23.1	23.1-23.2	7.63	12.773	0.597	13.426	0.693
23.0	23-23.1	7.61	12.745	0.596	13.386	0.692
22.9	22.9-23	7.58	12.705	0.595	13.346	0.691
22.8	22.8-22.9	7.53	12.675	0.594	13.306	0.690
22.7	22.7-22.8	7.50	12.640	0.593	13.266	0.689
22.6	22.6-22.7	7.46	12.604	0.592	13.226	0.688
22.5	22.5-22.6	7.43	12.570	0.591	13.187	0.687
22.4	22.4-22.5	7.39	12.535	0.59	13.147	0.686
22.3	22.3-22.4	7.36	12.500	0.589	13.108	0.685
22.2	22.2-22.3	7.33	12.465	0.588	13.068	0.684
22.1	22.1-22.2	7.30	12.430	0.587	13.028	0.683
22	22.0-22.1	7.26	12.395	0.586	12.988	0.682